# Электронная структура и спектральные характеристики клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>

© С.И. Курганский<sup>¶</sup>, Н.А. Борщ, Н.С. Переславцева\*

Воронежский государственный университет, 394006 Воронеж, Россия \* Воронежская государственная технологическая академия, 394000 Воронеж, Россия

(Получена 2 февраля 2005 г. Принята к печати 3 февраля 2005 г.)

Представлены результаты расчета электронной структуры клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>. Для расчетов использовался метод линеаризованных присоединенных плоских волн. В результате расчета были получены зонная структура, полные и парциальные плотности электронных состояний, а также рентгеновские эмиссионные SiK<sub> $\beta$ 1,3</sub>- и SiL<sub>2,3</sub>-спектры. Для клатрата Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> приводится сопоставление рассчитанных спектров с экспериментальными.

#### 1. Введение

Кремниевые клатраты впервые были синтезированы в 1965 году [1]. Однако только в последние годы они стали объектом интенсивных экспериментальных и теоретических исследований [2-6]. Такой интерес вызван прежде всего активным поиском новых полупроводниковых материалов. Поскольку кремний является самым распространенным и доступным полупроводником, многие исследования направлены на получение новых наноформ именно кремния. Клатраты представляют собой весьма перспективные с этой точки зрения соединения. При синтезе кремниевых клатратных соединений существовала проблема стабилизации кремниевой клатратной структуры. Решить ее удалось путем внедрения в полости полупроводниковой решетки атомов щелочных и (или) щелочноземельных металлов [7,8]. При этом оказалось, что атомы металлов сильно влияют на свойства кремниевых клатратных соединений. Так, клатраты M<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> (M=Na, K) являются термоэлектрическими материалами, обладают предельно низкой теплопроводностью [6]. Частичная замена атомов Na на атомы Ва приводит к появлению сверхпроводящих свойств. Клатрат  $Na_x Ba_{8-x} Si_{46}$  становится сверхпроводником при температуре 2-4 К, в зависимости от соотношения концентраций атомов Na и Ba [9,10]. При замене всех атомов Na на атомы Ва температура сверхпроводящего перехода повышается до 8 К [8]. Таким образом, путем легирования кремниевой клатратной структуры атомами различных металлов реальным становится получение соединений с заданными свойствами. Однако изучение влияния различных примесей на свойства кремниевых клатратных соединений невозможно без детального исследования электронной структуры кремниевых и кремниево-металлических клатратов. В данной работе мы представляем расчет электронной структуры клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>. На основе проведенного расчета нами были получены такие характеристики электронной структуры, как полные и парциальные плотности электронных состояний, а также рентгеновские эмиссионные Si $K_{\beta 1,3}$ - и Si $L_{2,3}$ -спектры. Кроме того, нами также был проведен расчет электронной структуры кристаллического кремния *c*-Si, на основе которого были получены Si $K_{\beta 1,3}$ - и Si $L_{2,3}$ -спектры. Для клатрата Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния приводится сопоставление рассчитанных спектров с экспериментальными [11].

#### 2. Детали расчета

Расчет электронной структуры клатратных соединений Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si проводился методом линеаризованных присоединенных плоских волн (ЛППВ) [12] в рамках локального приближения функционала плотности с использованием обменно-корреляционного потенциала в аппроксимации [13] и скалярно-релятивистского приближения [14]. В этом приближении учитываются все релятивистские эффекты, кроме спин-орбитального расщепления. Реализованный нами метод ЛППВ ранее успешно применялся для расчетов электронной структуры и спектральных характеристик силицидов переходных металлов [15-17]. Для расчетов электронной структуры клатратов использовался базис в 1213 ЛППВ, а для кристаллического кремния c-Si — 113 ЛППВ. В разложении базисной функции по сферическим гармоникам учитывались вклады до  $l_{\text{max}} = 5$ .

С помощью полученных в результате зонного расчета собственных функций  $\psi_{i,\mathbf{k}}(\mathbf{r})$  и собственных значений энергии  $E_i(\mathbf{k})$  в одноэлектронном приближении вычислялась интенсивность рентгеновских эмиссионных спектров:

$$I(E) = \frac{2}{\Omega_{BZ}} \sum_{i} \int_{\Omega_{BZ}, E_i(\mathbf{k}) \le E_{\rm F}} \left\{ M_i^2(\mathbf{k}) \delta \left( E - E_i(\mathbf{k}) + E_c \right) \right\} d\mathbf{k}$$

(i -номер энергетической зоны,  $\Omega_{BZ} -$ объем зоны Бриллюэна,  $E_c$  - энергия остовного состояния, на

<sup>¶</sup> E-mail: ssd18@phys.vsu.ru

**Таблица 1.** Координаты атомов в клатратах Si<sub>46</sub> [11] и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> [12] в единицах параметра элементарной ячейки a = 10.069 Å для Si<sub>46</sub>, a = 10.196 Å для Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>

Позиция	x		у		z	
атома	Si <sub>46</sub>	Na <sub>8</sub> Si <sub>46</sub>	Si <sub>46</sub>	Na <sub>8</sub> Si <sub>46</sub>	Si <sub>46</sub>	Na <sub>8</sub> Si <sub>46</sub>
Si1(6c)	0.25	0.25	0	0	0.5	0.5
Si2(16 <i>i</i> )	0.1840	0.1851	0.1840	0.1851	0.1840	0.1851
Si3(24 <i>k</i> )	0	0	0.3160	0.3077	0.1170	0.1175
Na1(2a)	_	0	_	0	_	0
Na2(6b)	—	0.25	—	0.5	—	0

которое происходит переход,  $M_i^2(\mathbf{k})$  — матричный элемент вероятности рентгеновского перехода, при вычислении которого нами использовалось дипольное приближение).

Кремниевые и кремниево-металлические клатраты кристаллизуются в примитивную кубическую ячейку, пространственная группа Pm3n [3,18]. Кристаллическая решетка строится из двух додекаэдров Si<sub>20</sub> и шести тетракаидекаэдров Si<sub>24</sub>, соединенных между собой. В Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> пустоты в полиэдрах заняты атомами Na. В структуре имеется две неэквивалентные позиции атомов натрия (2*a* и 6*b*) и три неэквивалентных позиции атомов кремния: 6*c*, 16*i* и 24*k*, с симметрией 4*m*2, 3 и *m* соответственно. Параметры элементарной ячейки, а также координаты атомов приведены в табл. 1.

### 3. Зонная структура

На рис. 1 представлена зонная структура клатратов  $Si_{46}$  (рис. 1, *a*) и  $Na_8Si_{46}$  (рис. 1, *b*) в прифермиевской области. Энергетические зоны в рассматриваемых соединениях имеют практически одинаковую структуру. Различие заключается только в относительном положении уровня Ферми. Объяснение этого эффекта можно провести в рамках модели жестких зон [13]. Согласно этой модели, для изоструктурных соединений, которыми и являются клатраты  $Si_{46}$  и  $Na_8Si_{46}$ , характерна схожая структура энергетических зон. При легировании кремниевой структуры атомами Na увеличивается число валентных электронов (добавляется по одному валентному электрону от каждого атома металла), и поэтому растет заполнение зон, вследствие чего уровень Ферми смещается вверх.

В Si<sub>46</sub> полностью заполненными являются 92 энергетические зоны, уровень Ферми попадает в запрещенную зону. Таким образом, данное соединение является полупроводником. Ширина запрещенной зоны составляет 0.9 эВ.

В Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> уровень Ферми расположен в зоне проводимости, т. е. этот клатрат обладает металлическими свойствами. Уровень Ферми отсекает от зоны проводимости энергетический интервал, который имеет максимальную ширину в точке X, равную 0.6 эВ. Этот интервал отделен от основной части валентной зоны щелью шириной в 0.7 эВ.

Структура основной части валентной зоны в клатратах Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> идентична. В ней можно выделить две области, каждая из которых включает по 46 зон. В клатрате Si<sub>46</sub> эти области отделены друг от друга



**Рис. 1.** Зонная структура клатратов Si<sub>46</sub> (*a*) и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> (*b*) в прифермиевской области.

С.И. Курганский, Н.А. Борщ, Н.С. Переславцева

**Таблица 2.** Энергетические зазоры (в эВ) валентной зоны кристаллического кремния c-Si в точках  $\Gamma$ , X и L зоны Бриллюэна (обозначения направлений приняты в соответствии с [19])

Направление	Наш расчет	По данным [19]
$X_1 - X_4$	5.4	5.0
$\Gamma'_{25} - \Gamma_1$	12.3	11.7
$L_1 - L'_2$	2.9	2.7
$L_1 - L'_3$	6.1	6.4

щелью шириной в 2.0 эВ, а в Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> — щелью в 1.8 эВ. Ширина области, расположенной у дна валентной зоны, составляет 7.4 эВ в чисто кремниевом клатрате и уменьшается до 7.2 эВ в Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>. Область, расположенная ближе к уровню Ферми, хотя и включает также 46 зон, но значительно более узкая: 2.3 эВ в клатрате Si<sub>46</sub> и 2.5 эВ в Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>.

Структура рассчитанной нами валентной зоны кристаллического кремния *c*-Si в целом подобна хорошо известной из литературы. В табл. 2 мы сравниваем энергетические зазоры полученной нами валентной зоны в некоторых высокосимметричных точках зоны Бриллюэна с результатами (ставшего уже классическим) расчета эмпирическим методом ортогонализованных плоских волн [19].

#### 4. Плотность электронных состояний

На рис. 2 показаны полные и парциальные плотности электронных состояний (DOS) в клатратах Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>. Полные DOS в клатратных соединениях имеют схожие профили, но при легировании кремниевой структуры атомами Na происходит смещение уровня Ферми в область более высоких энергий, и он попадает в зону проводимости. Такая ситуация может быть интерпретирована, если обратиться к описанной выше модели жестких зон. Как было показано, при переходе от кремниевого клатрата к кремниево-натриевому структура зон остается практически неизменной, а изменяется только положение уровня Ферми. Следовательно, не должно быть существенных различий и в профилях полных DOS.

В клатрате Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> вклад от состояний атомов металла в полную DOS является незначительным. Во всем рассматриваемом энергетическом интервале преобладает вклад от электронных состояний атомов кремния. Как видно из рисунков, у потолка валентной зоны доминирующим является вклад *p*-состояний кремния, при движении в глубь валентной зоны преобладает вклад Si-*s*-состояний. Такая же ситуация наблюдается и в чисто кремниевом клатрате. Область, в которой больший вклад в полную DOS вносят Si-*p*-состояния, отделена от области с преобладанием Si-*s*-состояний щелью в 1.4 эВ в клатрате Si<sub>46</sub> и щелью в 1.7 эВ в Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>.



**Рис. 2.** Полная и парциальные плотности электронных состояний клатратов Si<sub>46</sub> (*a*) и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> (*b*).

Физика и техника полупроводников, 2005, том 39, вып. 10

### 5. Рентгеновские эмиссионные спектры

На рис. 3 и 4 показаны полученные в результате расчета Si $K_{\beta 1,3}$ - и Si $L_{2,3}$ -спектры клатратных соединений Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si, а в табл. 3 и 4 приведены энергетические положения основных особенностей спектров. Для кристаллического кремния и легированного клатрата проводится также сопоставление рассчитанных спектров с экспериментальным [11]. Совмещение теоретического и экспериментального спектров проводилось по положению главного максимума.

Si $K_{\beta 1,3}$ -спектры соответствуют  $3p \rightarrow 1s$  переходам, т. е. отражают валентные *p*-состояния кремния. В  $K_{\beta 1,3}$ спектре кремниевого клатрата выделяются две особенности: главный максимум *B* в прифермиевской области и значительно менее интенсивный максимум *A* при энергии -5.2 эВ. Максимум *B* имеет сложную структуру с дополнительной особенностью *B*<sup>'</sup>. В спектре Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> главный максимум смещается в глубь валентной зоны, а около уровня Ферми появляется максимум *C*. Появление этой особенности можно интерпретировать, если обратиться к рис. 2, где показаны плотности электронных



**Рис. 3.** Рентгеновские эмиссионные рассчитанные и экспериментальные [11] Si  $K_{\beta 1,3}$ -спектры клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si.

Физика и техника полупроводников, 2005, том 39, вып. 10



**Рис. 4.** Рентгеновские эмиссионные рассчитанные и экспериментальные [11] Si L<sub>2,3</sub>-спектры клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si.

состояний. Как уже говорилось, в легированном клатрате уровень Ферми смещается в зону проводимости. Это и приводит к возникновению в  $SiK_{\beta 1,3}$ -спектре дополнительной особенности вблизи  $E_F$ . Сравнение  $SiK_{\beta 1,3}$ спектров клатратов и кристаллического кремния *c*-Si показывает, что в целом структура спектров идентична, однако можно отметить и некоторые отличия. Главный максимум *B* в спектре кристаллического кремния имеет симметричную форму, тогда как в спектрах клатратов этот максимум расщеплен и асимметричен.

SiL<sub>2,3</sub>-спектры соответствуют  $3s 3d \rightarrow 2p$  переходам и, следовательно, отражают Si3s- и Si3d-состояния валентной зоны. В спектрах рассматриваемых клатратов доминирует вклад Si3s-состояний, а вклад 3d-состояний кремния является значительно меньшим.

В SiL<sub>2,3</sub>-спектре клатрата Si<sub>46</sub>, как и в спектре кристаллического кремния, можно выделить три особенности, которые обозначены на рис. 4 как A, B и C. В спектре Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> появляется дополнительный максимум D в прифермиевской области. Его появление обусловлено, как и в случае SiK<sub> $\beta$ 1,3</sub>-спектра, смещением уровня Ферми в зону проводимости.

**Таблица 3.** Энергетическое положение особенностей (в эВ, относительно уровня Ферми) в Si  $K_{\beta 1,3}$ -спектрах клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si

	Si <sub>46</sub>	Na	a <sub>8</sub> Si <sub>46</sub>	c-Si	
Особенность		расчет	экспери- мент [11]	расчет	экспери- мент [11]
Α	-5.2	-6.5	-6.9	-6.8	-6.9
В	-0.6	-2.2	-2.2	-2.0	-2.0
B'	-1.3	-2.8	-3.0	_	-
С	-	-0.2	0.8	—	—

**Таблица 4.** Энергетическое положение особенностей (в эВ, относительно уровня Ферми) в Si $L_{2,3}$ -спектрах клатратов Si<sub>46</sub> и Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> и кристаллического кремния *c*-Si

		Na	a <sub>8</sub> Si <sub>46</sub>	c-Si	
Особенность	Si <sub>46</sub>	расчет	экспери- мент [11]	расчет	экспери- мент [11]
Α	-8.4	-9.7	-9.7	-9.6	-9.5
В	-5.2	-6.7	-6.7	-7.0	-7.0
С	-1.3	-3.1	-4.0	-3.4	-3.5
D	—	-0.4	-0.7	—	-

Кроме этого отличия в L2.3-спектрах клатратов следует отметить, что в SiL2.3-спектре кремниевометаллического клатрата увеличивается относительная интенсивность максимума В и он превосходит максимум А. Из рис. 4, на котором приводится сопоставление экспериментального и рассчитанного SiL<sub>2.3</sub>-спектров, видно, что форма спектров и энергетическое положение особенностей совпадают. Некоторые расхождения наблюдаются только в соотношении интенсивностей основных максимумов. Причиной этого может быть неидеальная стехиометрия и кристаллическая структура реального клатрата Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub>. В представленном нами расчете исследовалась структура Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> с идеальным стехиометрическим составом и кристаллической структурой. Это и могло послужить причиной того, что относительные интенсивности особенностей экспериментального и рассчитанного спектров отличаются.

## 6. Заключение

1. Структура зон в клатратах  $Si_{46}$  и  $Na_8Si_{46}$  идентична. Различия заключаются только в положении уровня Ферми. Клатрат  $Si_{46}$  является полупроводником, тогда как  $Na_8Si_{46}$  обладает металлическими свойствами.

2. В полной плотности электронных состояний рассматриваемых клатратов вклад Si-s-состояний доминирует в глубине валентной зоны, тогда как около уровня Ферми преобладающим является вклад *p*-состояний кремния. Влияние состояний атомов металла в Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> на полную DOS является незначительным.

3. Si $K_{\beta 1,3}$ -спектр клатрата Si<sub>46</sub> имеет двухпиковую, а Si $L_{2,3}$ -спектр трехпиковую структуру. Легирование кремниевой структуры атомами Na приводит к появлению дополнительного максимума в прифермиевской области спектров.

4. Сравнение рассчитанных Si $K_{\beta 1,3}$ - и Si $L_{2,3}$ -спектров с экспериментальными [11] показывает хорошее согласие теории и эксперимента. Различие можно отметить только в соотношении интенсивностей основных максимумов. Мы интерпретируем такое расхождение как следствие неидеальной стехиометрии и кристаллической структуры реальных клатратов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Американского фонда гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского Союза (CRDF) и Министерства образования и науки Российской Федерации (грант Y2-P-10-11 программы "Фундаментальные исследования и высшее образование" (BRHE)).

#### Список литературы

- J.S. Kasper, P. Hagenmuller, M. Pouchard, C. Cros. Science, 150, 1713 (1965).
- [2] T. Yokoya, A. Fukushima, T. Kiss. Phys. Rev. B, 64, 172 504 (2001).
- [3] K. Moriguchi, M. Yonemura, A. Shintani, S. Yamanaka. Phys. Rev. B, 61, 9859 (2000).
- [4] L. Qui, M.A. White, Z. Li, J.S. Tse, C.I. Ratcliffe, C.A. Tulk, J. Dong, O.F. Sankey. Phys. Rev. B, 64, 24 303 (2001).
- [5] R.F.W. Herrmann, K. Tanigaki, T. Kawaguchi, S. Kuroshima, O. Zhou. Phys. Rev. B, 60, 13 245 (1999).
- [6] J.S. Tse, K. Uehara, R. Rousseau, A. Ker, C.I. Ratcliffe, M.A. White, G. MacKay. Phys. Rev. Lett., 85, 114 (2000).
- [7] C. Cros, M. Pouchard, P. Hagenmuller. J. Sol. St. Chem., 2, 570 (1970).
- [8] S. Yamanaka, E. Enishi, H. Fukuoka, M. Yasukawa. Inorg. Chem., 39, 56 (2000).
- [9] H. Kawaji, H. Horie, S. Yamanaka, M. Ishikawa. Phys. Rev. Lett., 74, 1427 (1995).
- [10] S. Yamanaka, H. Horie, H. Nakano, M. Ishikawa. Fullerene Sci. Technol., 3, 21 (1995).
- [11] A. Moewes, E.Z. Kurmaev, J.S. Tse, M. Geshi, M.J. Ferguson, V.A. Trofimova, Y.M. Yarmoshenko. Phys. Rev. B, 65, 153 106 (2002).
- [12] S.N. Vosko, L. Wilk, M. Nusair. Can. J. Phys., 58, 1200 (1980).
- [13] D.D. Koelling, G.O. Arbman. J. Phys. F, 5, 2041 (1975).
- [14] A.H. MacDonald, W.E. Pickett, D.D. Koelling. J. Phys. C, 13, 2675 (1980).
- [15] С.И. Курганский, Н.С. Переславцева, Е.В. Левицкая. ФТТ, 45, 193 (2003).
- [16] S.I. Kurganskii, N.S. Pereslavtseva, E.V. Levitskaya, Yu.A. Yurakov. Phys. Status Solidi B, 223 (2), 306 (2002).
- [17] S.I. Kurganskii, N.S. Pereslavtseva, E.V. Levitskaya, Yu.A. Yurakov, I.G. Rudneva, E.P. Domashevskaya. J. Phys.: Condens Matter., 14, 6833 (2002).

- [18] G.K. Ramachandran, P.F. McMillan, J. Diefenbacher, J. Gryko, J. Dong, O.F. Sankey. Phys. Rev. B, 60, 12 294 (1999).
- [19] F. Herman, R. Kortum, C. Kuglin. Int. J. Quant. Chem., IS, 533 (1967).

Редактор Л.В. Беляков

# Electronic structure and spectral properties of Si<sub>46</sub> and Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> clathrates

S.I. Kurganskii, N.A. Borsch, N.S. Pereslavtseva \*

Voronezh State University, 394006 Voronezh, Russia \* Voronezh State Technological Academy, 394000 Voronezh, Russia

**Abstract** In this work, the results of electronic structure of Si<sub>46</sub> and Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> clathrates are presented. In calculation the linearized augmented plane wave method was used. Band structure, total and partial density of states and *x*-ray emission Si $K_{\beta 1,3}$ - and Si $L_{2,3}$ -spectra were obtained as results of the calculation. The comparison of calculated and experimental spectra for Na<sub>8</sub>Si<sub>46</sub> are presented.